

## Сведения о ведущей организации

Полное наименование организации	Лаборатория Космического материаловедения ИК РАН – филиал Федерального государственного учреждения «Федеральный научно-исследовательский центр «Кристаллография и фотоника» Российской академии наук
Сокращенное наименование организации	ЛКМ ИК РАН – филиал ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН
Место нахождения	г. Калуга
Почтовый адрес	248640, Россия, Калуга, ул. Академическая, дом 8
Телефон, адрес электронной почты, сайт	т. 8 (4842) 76-27-67, e-mail: kmikran@spark-mail.ru, <a href="http://www.crys.ras.ru">http://www.crys.ras.ru</a>

## Список публикаций работников по теме диссертации за последние 5 лет

1. Стрелов В.И., Прохоров И.А., Коробейникова Е.Н., Сидоров В.С., Власов В.Н., Артемьев В.К. Развитие технологии роста высокооднородных кристаллов полупроводников // Кристаллография. 2018. Т. 63. № 2. С. 307-310.
2. Кожемякин Г.Н., Артемьев В.К., Стрелов В.И., Сидоров В.С., Коробейникова Е.Н. Поведение расплава в вертикальном методе Бриджмена с низким аксиальным градиентом температуры // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2018. № 3. С. 98-105.
3. Михеев Н.Н., Колесник А.С. Универсальная функция генерации информативных сигналов для количественных методов растровой электронной микроскопии // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2017. № 12. С. 54-61.
4. Стрелов В.И., Захаров Б.Г., Артемьев В.К. Макронеоднородность свойств кристаллов полупроводников, обусловленная спецификой поведения расплава в условиях микрогравитации // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2016. № 10. С. 38-49.
5. Михеев Н.Н., Никифорова Н.А., Ганчев А.С. Латеральное распределение потерь энергии пучка электронов в веществе при нормальном падении заряженных частиц на поверхность образца // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2015. № 9. С. 64-69.
6. Никифорова Н.А., Степович М.А., Михеев Н.Н., Hocker M., Tischer I. Измерение диффузионной длины и времени жизни свободных экситонов в нитриде галлия катодолюминесцентным методом при различных условиях возбуждения люминесценции // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2015. № 8. С. 84-88.

7. Прохоров И.А., Асадчиков В.Е., Роцин Б.С., Стрелов В.И., Ральченко В.Г., Большаков А.П. Рентгенодифракционная характеристика синтетических кристаллов граната, алмаза и сапфира // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2015. № 5. С. 52-60.
8. Михеев Н.Н., Степович М.А., Широкова Е.В., Филиппов М.Н. Методика количественного рентгеноспектрального микроанализа с учетом матричных эффектов // Перспективные материалы. 2014. № 2. С. 77-82.
9. Михеев Н.Н. Решение прямой задачи количественного рентгеноспектрального микроанализа для бинарных сплавов известного состава // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2014. № 9. С. 66-71.